

超低EMI, 4.5W×2, 双通道带立体声耳机模式D类音频放大器

概要

CS8563S是一款双桥音频功率放大器芯片, 采用6.0V 电源供电; 在THD+N 等于10% 情况下, 能为一个4Ω 的负载提供4.5W 的连续功率。此外, 当接立体耳机时, 芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。

CS8563S双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的, 它采用表面贴装技术, 只需少量的外围器件, 便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8563S采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式, 简化了音频系统的外围电路设计。

CS8563S内置了低功耗待机电路和过热保护电路, 同时内置了杂音消除电路, 可以消除芯片启动和关断过程中的咔嚓声或噼噎声。

CS8563S提供了SOP16L的封装形式, 额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

15879109929

描述

- 每通道输出功率
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 6V$
 - $R_L = 8\ \Omega$ 2.30W(每通道)
 - $R_L = 4\ \Omega$ 4.50W(每通道)
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 5.0V$
 - $R_L = 8\ \Omega$ 1.60W(每通道)
 - $R_L = 4\ \Omega$ 3.20W(每通道)
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 3.6V$
 - $R_L = 8\ \Omega$ 0.90W(每通道)
 - $R_L = 4\ \Omega$ 1.70W(每通道)
- 工作电压范围: 2.7V到6.2V
- “咔嚓声和噼噎声”抑制电路
- SE模式, $R_L = 32\ \Omega$ 输出平均功率75mW, $THD_{(max)} < 0.1\%$
- 低关断电流 ($< 0.1\ \mu A$)
- 过流保护, 短路保护和热保护
- 符合RoHS的无铅封装
- <http://www.junyi-ic.com>

封装

SOP16L

应用:

- LCD-TV
- 笔记本电脑
- 数码相框
- USB接口的扬声器

典型应用线图

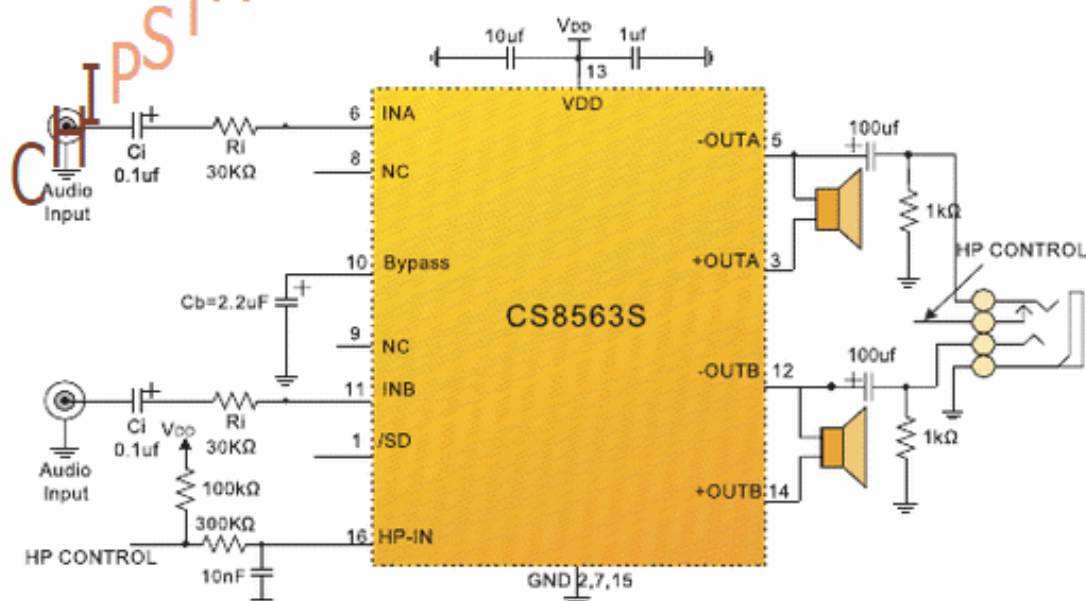
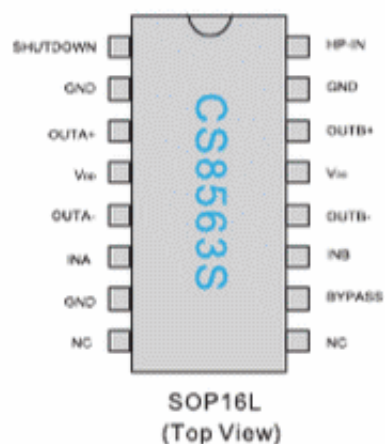


图 1 CS8563S应用线路图

管脚排列以及描述(图2)



管脚说明

CS8563S管脚	说明	输入/输出	功能
1	SHUTDOWN	输入	关断端口,高电平关断
2,7,15	GND	地	接地端
3	OUTA+	输出	正向输出端A
4,13	VDD	电源	电源端
5	OUTA-	输出	反向输出端A
6	INA	输入	音频信号输入端A
8	NC	—	NC管脚
9	NC	—	NC管脚
10	BYPASS	输入	电压基准端
11	INB	输入	音频信号输入端B
12	OUTB-	输出	反向输出端B
14	OUTB+	输出	正向输出端B
16	HP-IN	输入	耳机/立体模式选择

极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	无信号输入时供电电源	6.5	V
V _I	输入电压	-0.3 to VDD+0.3	V
T _J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T _{SDR}	引脚温度 (焊接15秒)	220	°C
T _{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	电源电压	2.7~6.2	V
T _A	环境温度范围	-40~85	°C
T _J	结温范围	-40~150	°C

热效应信息

参数	描述	数值	单位
θ_{JA}	封装热阻---芯片到环境热阻	20	°C/W
θ_{JC}	封装热阻---芯片到封装表面热阻	80	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
CS8563S	SOP16L		13"	12mm	2500
CS8563S	SOFT16L		管装		50

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV

ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。

电气参数 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS8563S			单位
			最小值	典型值	最大值	
V _{DD}	供电电源		2.7			V
					6.2	V
I _{DD}	静态电流	V _{IN} =0V, I _o =0A, HP-IN=0V		10	13	mA
		V _{IN} =0V, I _o =0A, HP-IN=4V		7		
I _{SD}	关断电流	Shutdown管脚接地		0.04	1	μA
V _{IH}	SD, HP管脚输入高电平				4.0	V
V _{IL}	SD, HP管脚输入低电平		0.9			V

桥接模式电气特性 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS8563S		单位
			典型值	极限值	
V _{OS}	输出失调电压	V _{IN} = 0V	5	50	mV(max)
P _o	输出功率	THD+N = 10%, f = 1 kHz, R _L = 4Ω, V _{DD} = 6V	4.55		W
		THD+N = 1%, f = 1 kHz, R _L = 4Ω, V _{DD} = 6V	3.70		W
		THD+N = 10%, f = 1 kHz, R _L = 4Ω, V _{DD} = 5V	3.20		W
		THD+N = 1%, f = 1 kHz, R _L = 4Ω, V _{DD} = 5V	2.60		W
		THD+N = 1%, f = 1 kHz, R _L = 32Ω, V _{DD} = 5V	0.37		W
T _{WU}	启动时间	V _{DD} = 5.0V, C _{bypass} = 2.2μF	400		ms
THD+N	总谐波失真	20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz, A _{VD} = 2	0.2		%
		CS8563S, R _L = 4Ω, P _o = 2W CS8563S, R _L = 8Ω, P _o = 1W	0.1		
PSRR	电源抑制比	V _{DD} = 5V, V _{RIIPPLE} = 200mV _{RMS} , R _L = 8Ω C _B = 1.0μF	67		dB
X _{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, C _B = 1.0 μF	90		dB
SNR	信噪比	V _{DD} = 5V, P _o = 1.1W, R _L = 8Ω	98		dB

单端模式电气特性 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS8563S		单位
			典型值	极限值	
V _{OS}	输出失调电压	V _{IN} = 0V	5	50	mV(max)
P _o	输出功率	THD+N=0.5%, f=1kHz, R _L =32Ω	85	75	mW(min)
		THD+N=1%, f=1kHz, R _L =8Ω	340		mW
		THD+N=10%, f=1kHz, R _L =8Ω	440		mW
THD+N	总谐波失真	20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz, A _{VD} = -1, P _o = 75mW, R _L = 32Ω	0.02		%
PSRR	电源抑制比	V _{RIIPPLE} = 200mV _{RMS} , R _L = 8Ω C _B = 1.0uF	52		dB
X _{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, C _B = 1.0 μF	60		dB
SNR	信噪比	V _{DD} = 5V, P _o = 340mW, R _L = 8Ω	95		dB

典型特征曲线

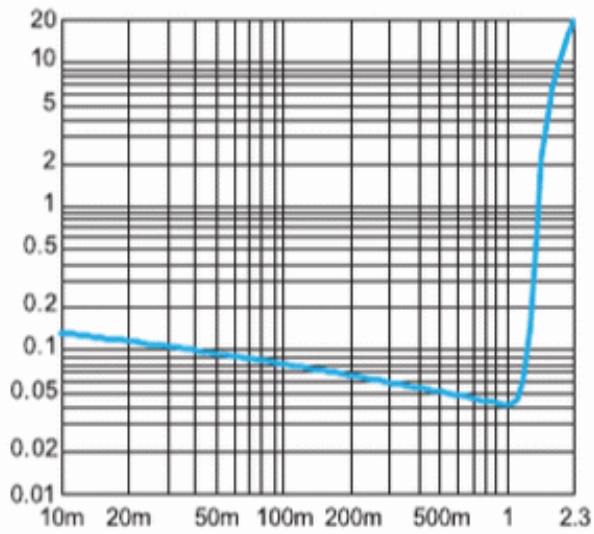


Figure 3. THD+N vs. Output Power
6V, 80ohm, BTL at f=1 kHz

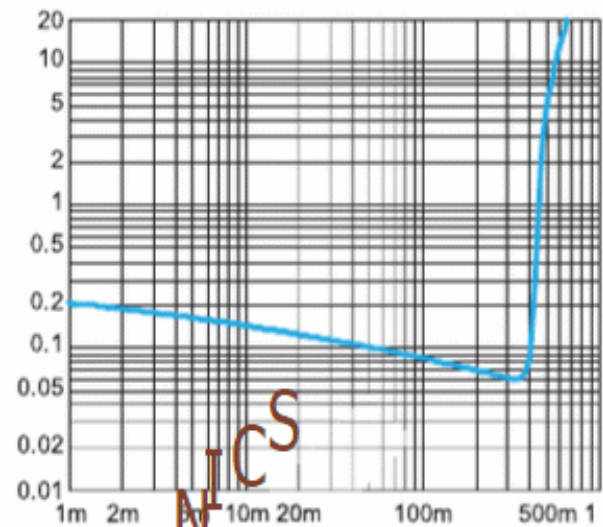


Figure 4. THD+N vs. Output Power
3V, 80ohm, BTL at f=1 kHz

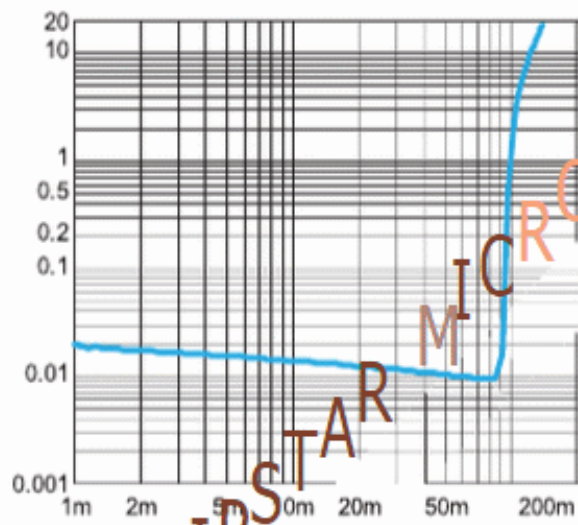


Figure 5. THD+N vs. Output Power
SE mode, 5V, 320ohm, f=1 kHz

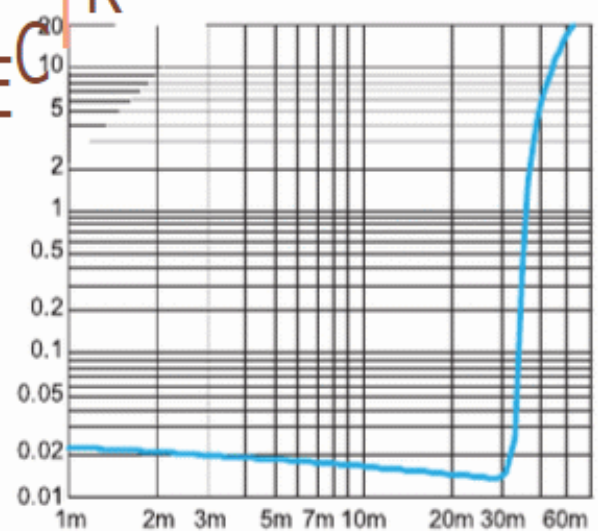


Figure 6. THD+N vs. Output Power
SE mode, 3V, 320ohm, f=1 kHz

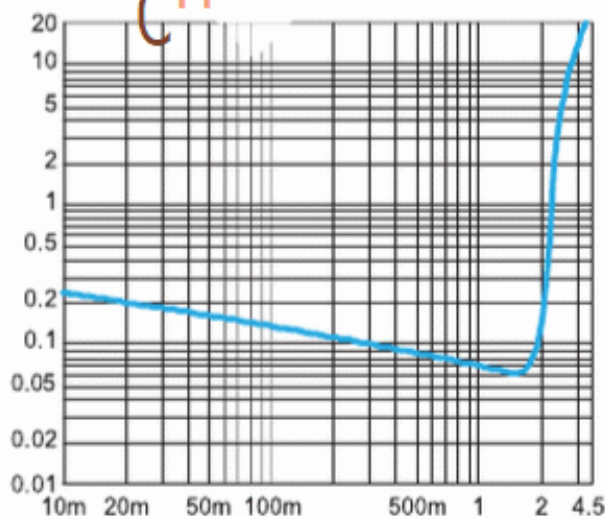


Figure 7. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 6V, 40ohm, f=1 kHz

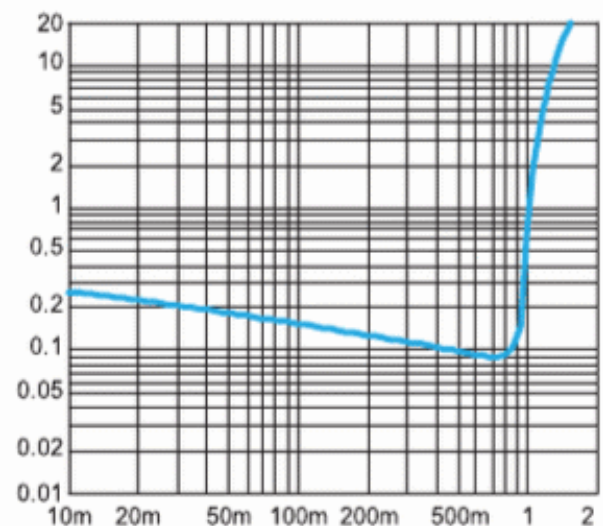


Figure 8. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 3V, 40ohm, f=1 kHz

典型特征曲线

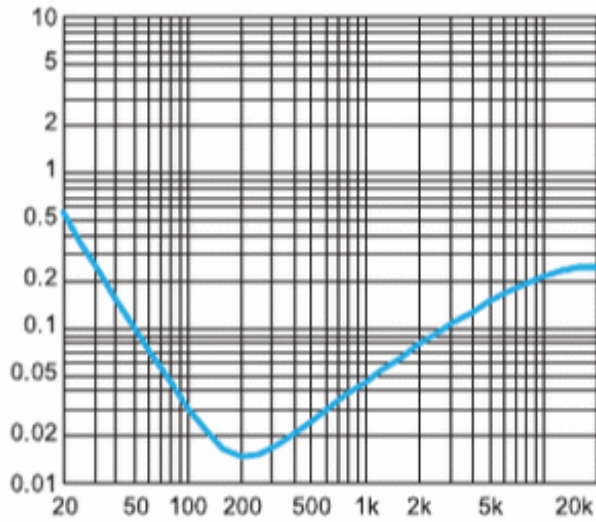


Figure 9. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 6V, 80Ohm, $P_o=800\text{mW}$

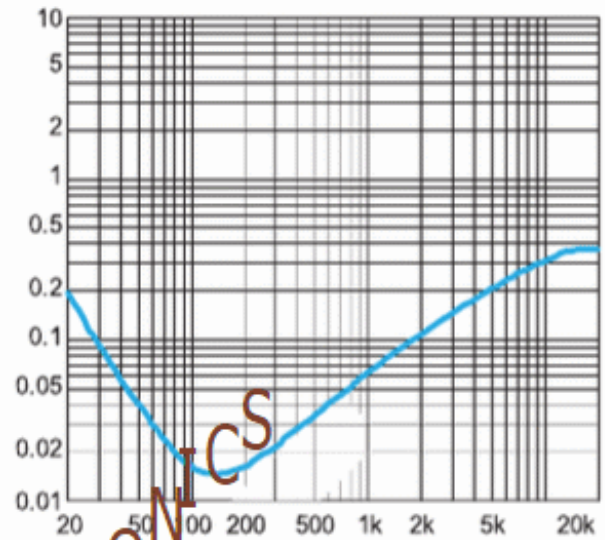


Figure 10. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 80Ohm, $P_o=300\text{mW}$

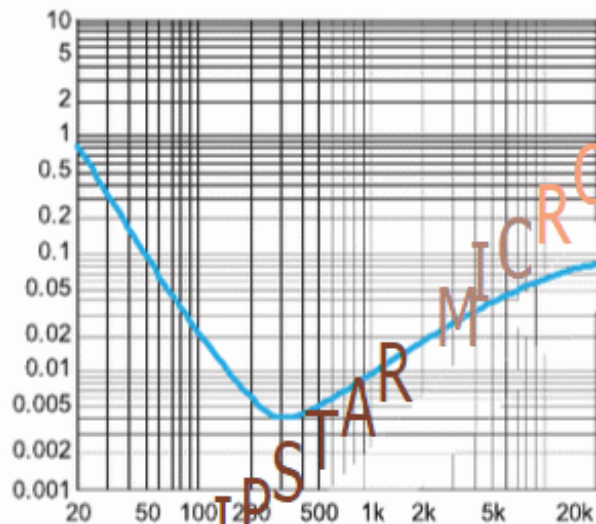


Figure 11. THD+N vs. Frequency
SE mode, 6V, 320Ohm, $P_o=70\text{mW}$

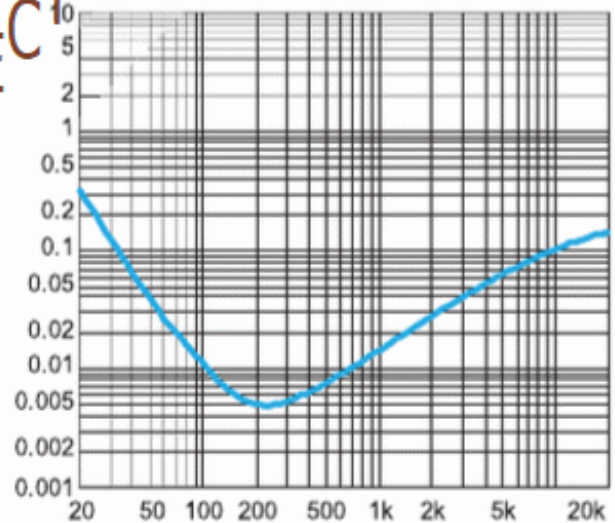


Figure 12. THD+N vs. Frequency
SE mode, 3V, 320Ohm, $P_o=20\text{mW}$

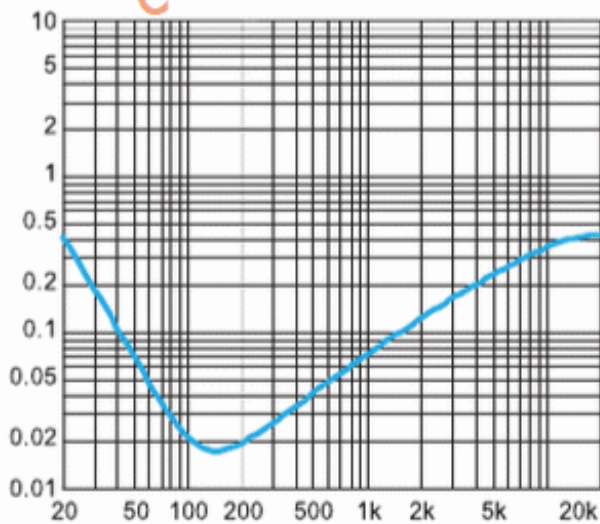


Figure 13. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 6V, 40Ohm, $P_o=1\text{W}$

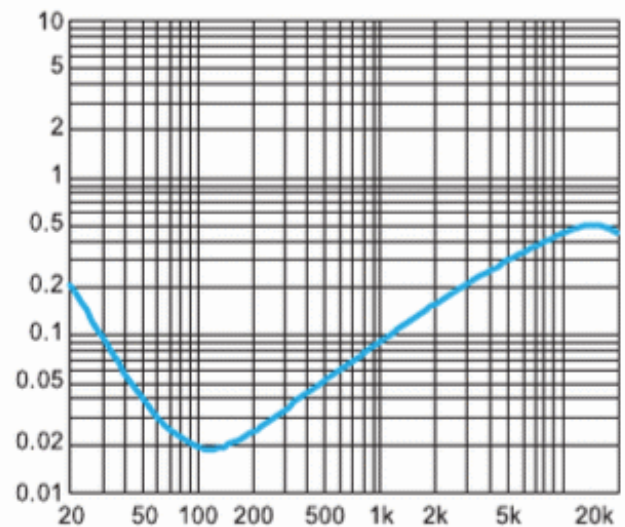


Figure 14. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 40Ohm, $P_o=500\text{mW}$

典型特征曲线

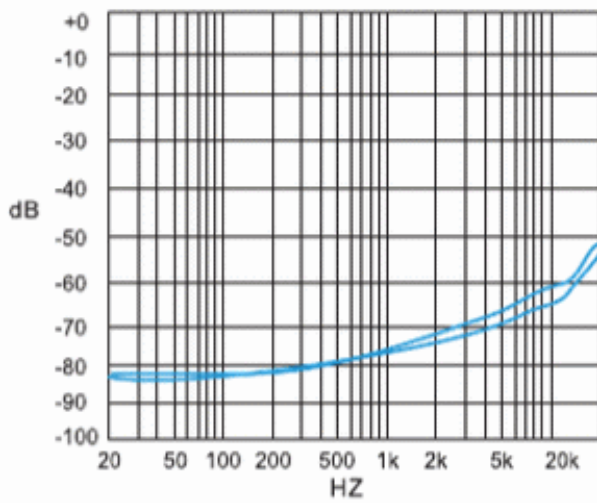


Figure 15. PSRR vs. Freq
BTL mode, 6V, 80ohm, 200mVpp
Input terminated

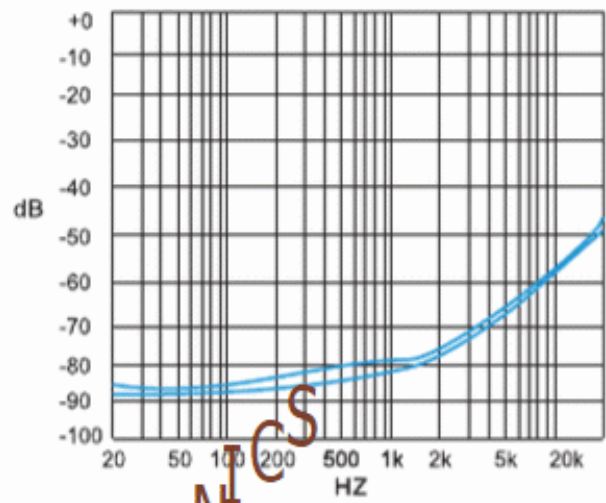


Figure 16. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80ohm, 200mVpp
Input terminated

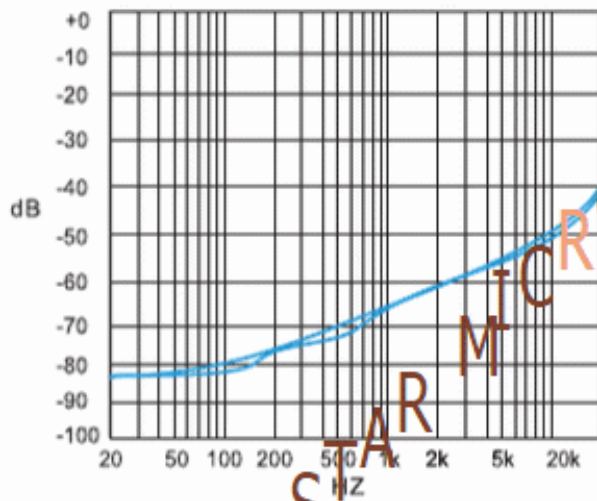


Figure 17. PSRR vs. Freq
BTL mode, 6V, 80ohm, 200mVpp
Input unterminated

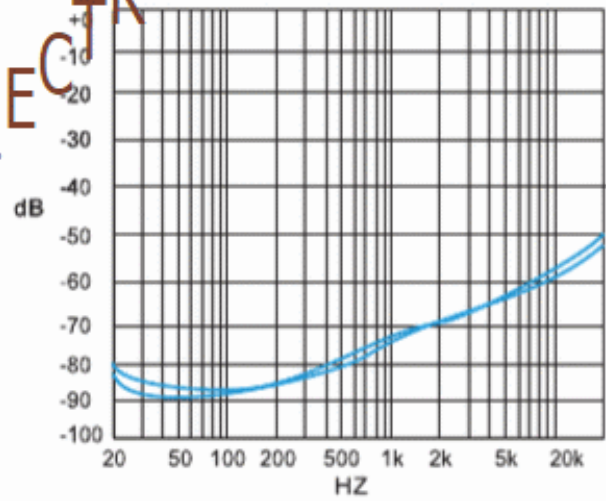


Figure 18. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80ohm, 200mVpp
Input unterminated

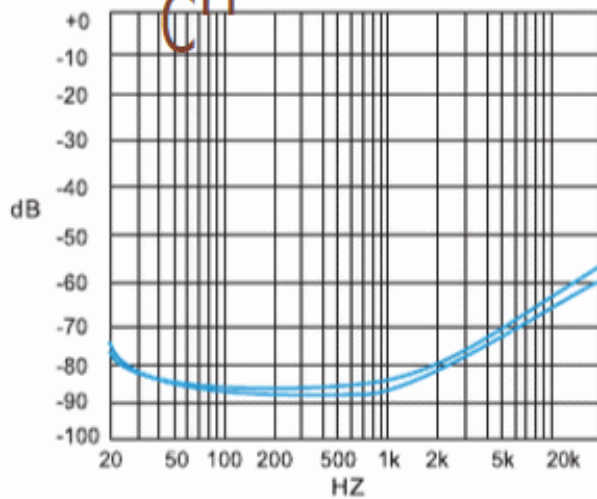


Figure 19. PSRR vs. Freq
SE mode, 6V, 320ohm, 200mVpp
Input terminated

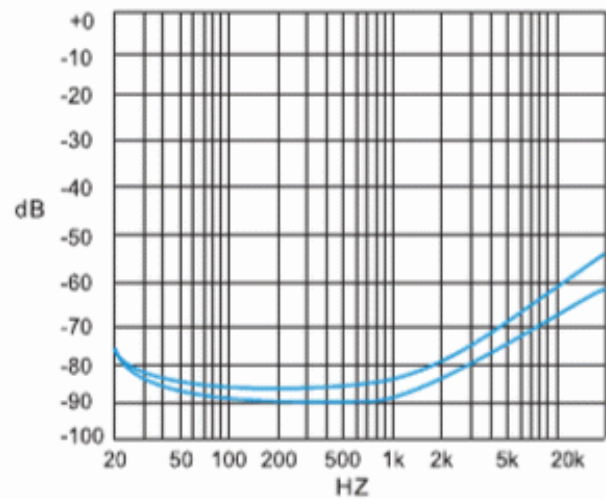


Figure 20. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320ohm, 200mVpp
Input terminated

典型特征曲线

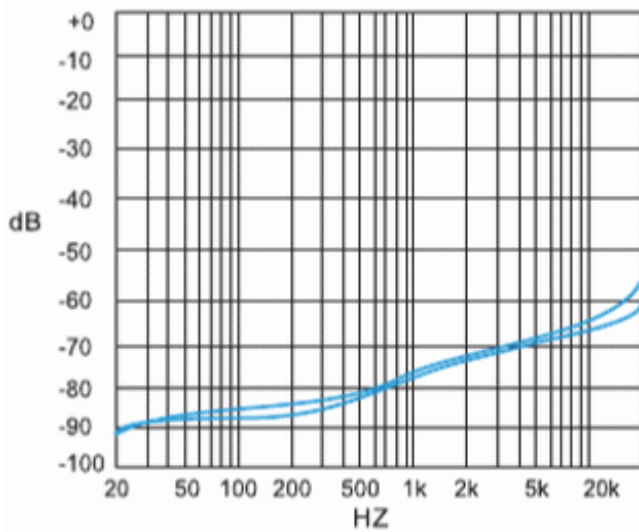


Figure 21. PSRR vs. Freq
SE mode, 6V, 320ohm, 200mVpp
Input unterminated

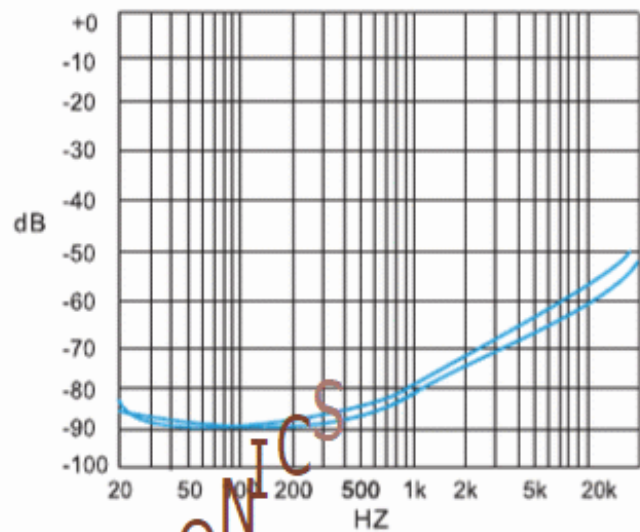


Figure 22. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320ohm, 200mVpp
Input unterminated

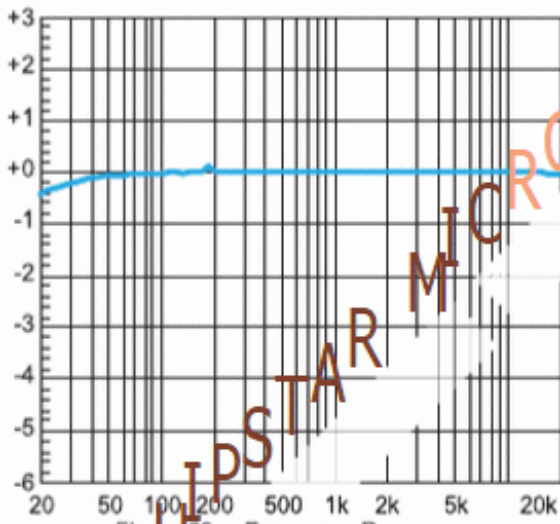


Figure 23. Frequency Response
BTL mode, 6V, 80ohm

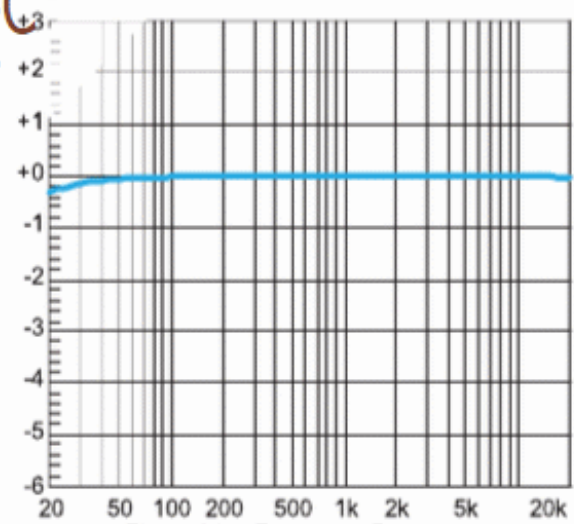


Figure 24. Frequency Response
BTL mode, 3V, 80ohm

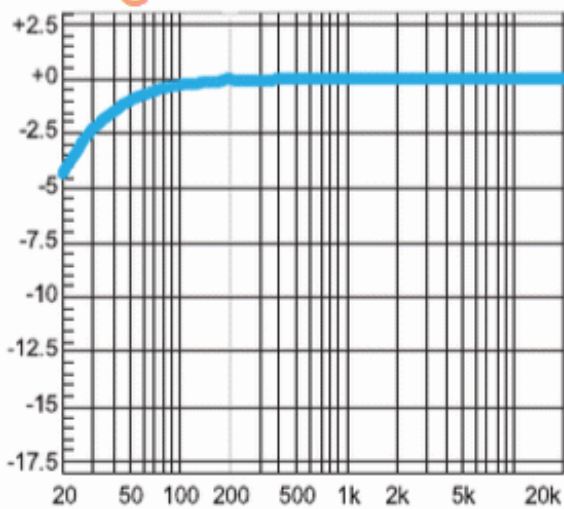


Figure 25. Frequency Response
SE mode, 6V, 320ohm, C5/C6=220uF

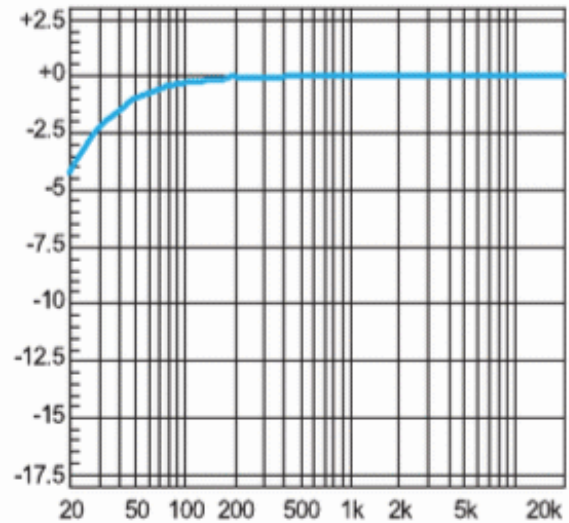


Figure 26. Frequency Response
SE mode, 3V, 320ohm, C5/C6=220uF

典型特征曲线

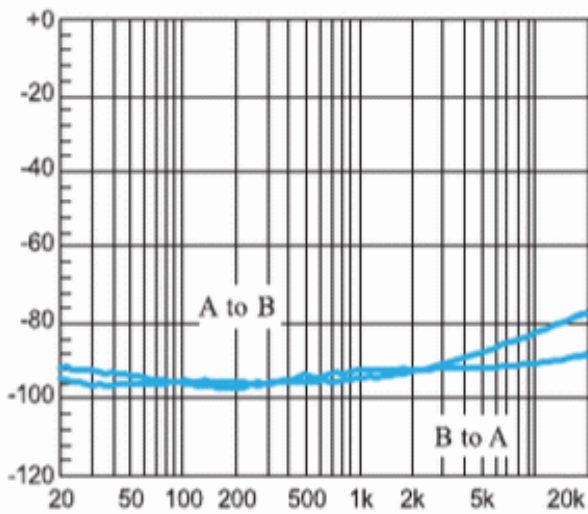


Figure 27. Crosstalk
BTL mode, 6V, 80Ohm, $P_o=1W$

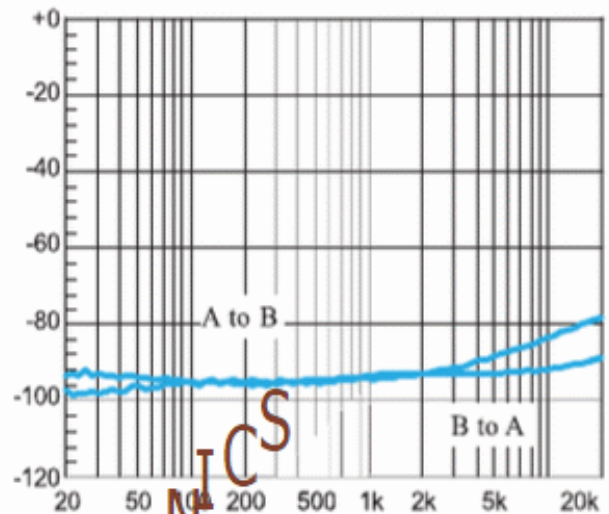


Figure 28. Crosstalk
BTL mode, 3V, 80Ohm, $P_o=0.3W$

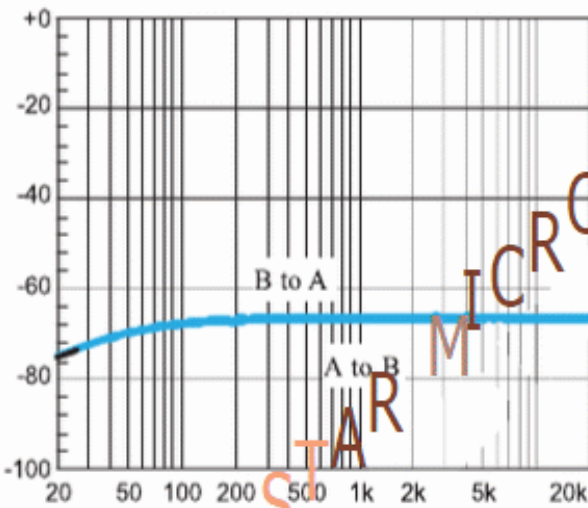


Figure 29. Crosstalk
SE mode, 6V, 320Ohm, $P_o=80mW$

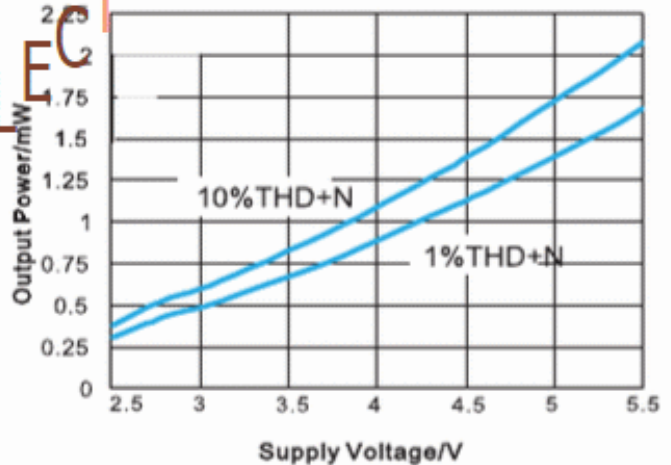


Figure 30. Output Power vs. Power Supply
BTL mode, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=8\text{ Ohm}$

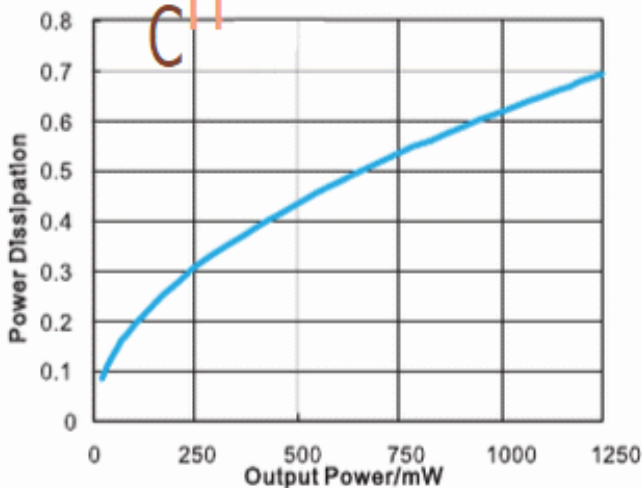


Figure 31. Power Dissipation vs. Output Power
BTL mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=80\text{ Ohm}$, $THD+N \le 1\%$

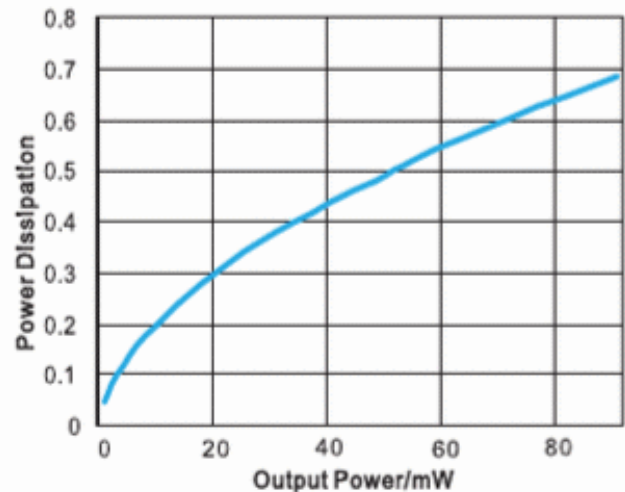


Figure 32. Power Dissipation vs. Output Power
SE mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=320\text{ Ohm}$

应用信息

CS8563S基本结构描述

CS8563S是双端输出的立体声音频功率放大器，内部集成两级四个运算放大器，构成双通道（A,B通道）立体音频放大器，（以下为A通道的论述，同时也适合于B通道）放大器A1的增益是外部配置结构决定的，闭环增益通过配置 R_f 和 R_i 来决定；而放大器A2的增益有内部电阻结构决定，固定为-1，A2构成倒相放大器。驱动负载连接到两个放大器输出端之间。放大器A1的输出作为放大器A2的输入，这样导致两个放大器产生幅值相同，相位差 180° ，利用相位不同，当负载连接于-OUTA和+OUTA输出端之间且为差动输出时（通常被称作“桥式模型”），该IC各通道的差动增益为：

$$A_{vd} = 2 \times \frac{R_f}{R_i} \quad (1)$$

CS8563S的反馈电阻 $R_f = 300\text{k}\Omega$ ，输入电阻 R_i 为 $30\text{k}\Omega$ ，所以闭环增益是20dB。

桥式模型放大器的运行不同于单终端放大器结构，在单终端结构中负载的一端接放大器的输出而另一端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点：当它给负载提供差动驱动时，负载两端的电压为单终端情况下的两倍。因此，在相同条件下，假定放大器没有电流限制或断路，可获得的输出功率中，这种增加导致输出功率可能是单终端放大器的4倍。当选定一个的放大器闭环增益时，为了不引起过分失真（过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器），对电路的设计有一定的要求，请参考“音

过热保护

当芯片的温度超过 150°C 时，热保护电路将起作用，芯片自动被关断。由于芯片制造工艺的差异，不同的芯片之间最大有 $\pm 15^\circ\text{C}$ 的偏差，当温度降低 30°C 后CS8563S继续正常工作。

输入电容(C_i)

对于便携式设计，较大输入电容既昂贵又占用空间，因此需要恰当的输入耦合电容，但在许多应用便携式扬声器的例子中，无论内部还是外部，很少可以出现低于100Hz至150Hz的信号。因此使用一个大的输入电容不会增加系统性能，输入电容(C_i)和输入电阻(R_i)组成一个高通滤波器，截止频率为

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{in} C_{in}}$$

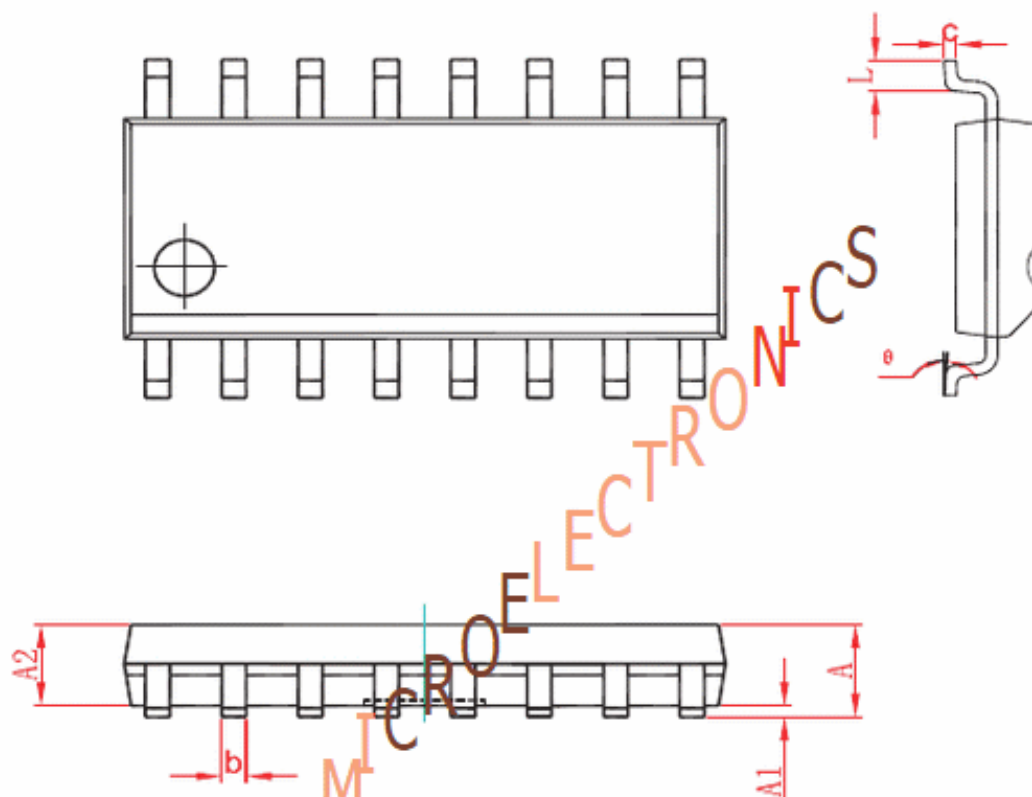
除了系统损耗和尺寸，POP声受输入耦合电容 C_i 的影响，较大的输入耦合电容需要更多的电荷才能到达它的静态电压（ $1/2V_{DD}$ ）。这些电荷需要内部反馈电路提供，因此，在保证低频性能的前提下，减小输入电容可以减少启动POP声。

模拟基准旁路电容(C_{BYP})

CHIPSTAR MICROELECTRONICS

封装信息

CS8563S SOP16L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	$^{\circ}0$	$^{\circ}8$	$^{\circ}0$	$^{\circ}8$

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-229标准